

2SD1586

NPN三重拡散形シリコントランジスタ 低周波電力増幅用

NPN Silicon Triple Diffused Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

特長/FEATURES

○多用途に使用でき、各種民生機器、事務器等の電源、ドライバとして最適です。

$$V_{CE0} \geq 100 \text{ V}, V_{EB0} \geq 7.0 \text{ V}, I_{C(DC)} \leq 4.0 \text{ A}$$

○絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。

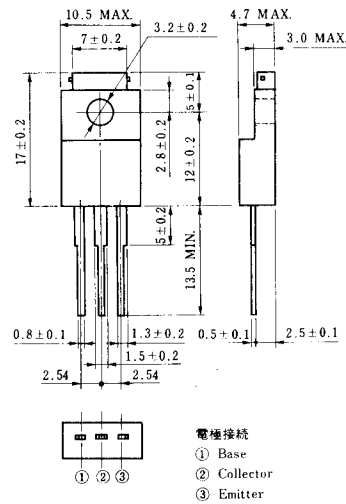
○コンプリメンタリトランジスタ：2SB1095

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	7.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	4.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	6.0	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	0.6	A
全損失	$P_T(T_c = 25^\circ\text{C})$	20	W
全損失	$P_T(T_a = 25^\circ\text{C})$	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 %

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



6

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 100 \text{ V}, I_E = 0$			10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = 7.0 \text{ V}, I_C = 0$			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE} **	$V_{CE} = 5.0 \text{ V}, I_C = 0.5 \text{ A}$	40	100	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = 3.0 \text{ A}, I_B = 0.3 \text{ A}$			1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C = 3.0 \text{ A}, I_B = 0.3 \text{ A}$			2.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 5.0 \text{ V}, I_C = 0.1 \text{ A}$		20		MHz

**パルス測定 PW ≤ 350 μs , Duty Cycle ≤ 2 % / Pulsed

h_{FE} 規格区分

捺印	M	L	K
h_{FE}	40 ~ 80	60 ~ 120	100 ~ 200